

06.2;12

©1994

К ВОПРОСУ О ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ВКЛЮЧЕНИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ ПРИ СПЕКТРОМЕТРИИ ИОНОВ

В.К. Ерёмин, И.Н. Ильяшенко, Н.Б. Строкан

В ряде задач ядерной спектрометрии возникает необходимость параллельного включения нескольких полупроводниковых детекторов. Таким путем можно реализовать систему большой площади и сложной конфигурации. Еще в ранних работах (см., например, [1]) успешно использовалось параллельное включение более десятка детекторов. Однако разрешающая способность (δ) как детекторов, так и системы была на уровне нескольких процентов. В последнее время для одиночного детектора достигнуты значения $\delta \cong 0.2\%$ ($\cong 8$ кэВ для α -частиц с энергией $\cong 5$ МэВ [2]). Возникает вопрос, возможно ли выдержать данный уровень разрешения при параллельном включении нескольких детекторов. С этой целью в работе сопоставляются условия формирования сигнала детектора при одиночном включении, либо работе в системе. Будет проанализирована эквивалентная схема и экспериментально определено различие в переносе заряда на примере Si-детекторов поверхностно-барьерного типа.

1. Эквивалентная схема детектора для общего случая (режим неполного обеднения структуры) представлена на рис. 1,*a*. Постоянная $R_b C_b$ равна значению времени максвелловской релаксации для проводимости базы; $C_{вх}$ и C — емкости на входе предусилителя и области пространственного заряда (ОПЗ) детектора соответственно; r — последовательное сопротивление структуры (например, сопротивление растекания тонкого проводящего слоя). Как показано в [3], данная схема адекватно отражает физику переноса неравновесных носителей в детекторе: В общем случае кинетика сигнала описывается суммой двух экспонент. Их постоянные времени определяются дрейфом носителей в ОПЗ и релаксацией базы.

В типичном случае роль базы сводится к увеличению постоянной дрейфа в d/w раз, где w — ширина ОПЗ, d — толщина детектора. Как правило, $d/w \lesssim 2$, что позволяет при анализе параллельного включения использовать более простую эквивалентную схему, не содержащую $R_b C_b$ (см. рис. 1,*b*). Последнее соответствует режиму полного

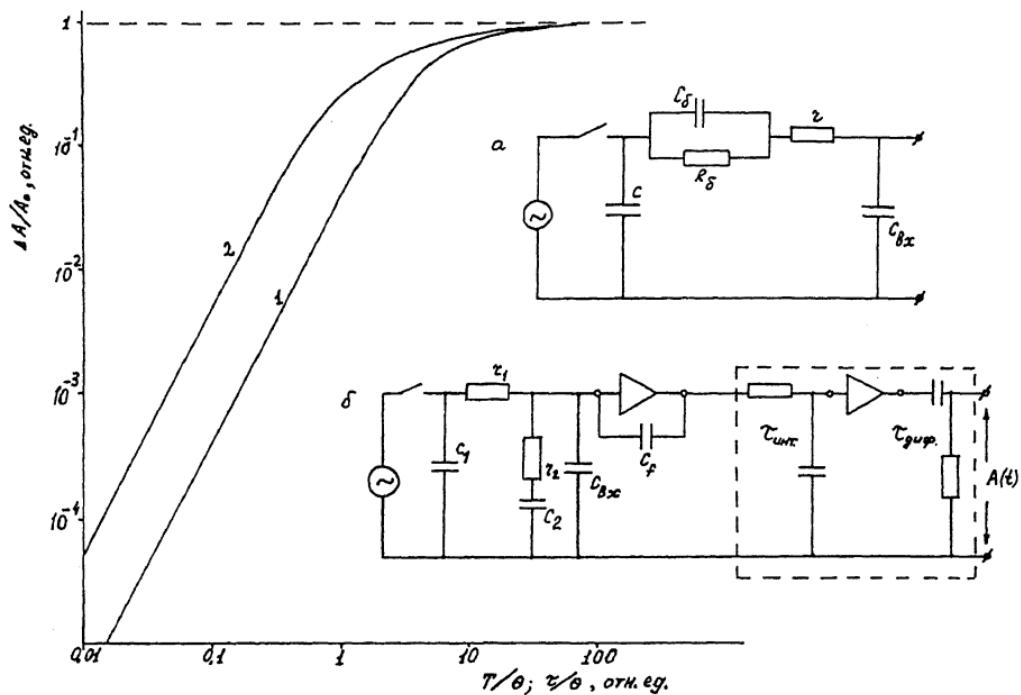


Рис. 1. Расчетные зависимости дефицита амплитуды при прохождении сигнала через фильтр с постоянной времени θ (см. фрагмент б).

Фронты нарастания сигнала: 1 — линейный, 2 — экспоненциальный. Фрагменты: а — полная эквивалентная схема детектора; б — анализируемая схема работы системы параллельных детекторов, подключенных к зарядочувствительному предуслышителю.

обеднения. Имеется в виду, что частица попала в детектор с параметрами C_1 и r_1 , а r_2C_2 представляет эквивалентную цепочку параллельно включенных n -детекторов. Пунктиром выделено стандартное RC — формирование сигнала в усилителе. Положим также, что ток, возникающий при попадании частицы в ОПЗ, имеет форму δ-импульса.

Выражение для напряжения на емкости $C_{\text{вх}}$ получается стандартным операторным методом. Учтем, далее, интегрирующие свойства предуслышителей с зарядовой обратной связью. Для них эквивалентная емкость входа $C_{\text{вх}}$ определяется в основном динамической емкостью $\cong 10^4$ пФ, что на два порядка больше емкости $C_{1,2}$. Тогда, пренебрегая величинами второго порядка малости, т.е. $(C_i/C_{\text{вх}})^2$, получаем для сигнала ($\tau_i = r_iC_i$):

$$V(t) \cong \frac{q(t)}{C_1 + C_2 + C_{\text{вх}}} =$$

$$= \frac{q}{C_1 + C_2 + C_{\text{экв}}} [1 - (1 - B) \exp(-t/\theta_1) - B \exp(-t/\theta_2)], \quad (1)$$

где

$$B = \frac{\beta_2 \tau_2}{(1 + \beta_2)\tau_1 - (1 + \beta_1)\tau_2}, \quad \beta_i = C_i/C_{\text{экв}}, \quad \theta_i = \frac{\tau_i}{1 + \beta_i}.$$

Поскольку для одного детектора $V(t) \sim [1 - \exp(-t/r_1 C_1)]$, видно, что подключение дополнительных детекторов кинетику сигнала существенным образом не изменяет. Действительно, амплитуда второй компоненты $B \sim \beta$, то есть составляет менее 2–3%. Постоянная $r_1 C_1$ также изменилась на величину β .

Сказанное выше наглядно проявляется в случае n -идентичных детекторов, когда $V(t)$ имеет вид:

$$V(t) = \frac{q}{nC + C_{\text{экв}}} \left[1 - \exp \left(-\frac{t}{\tau} \right) \left(1 + \frac{nC}{C_{\text{экв}}} \right) \right]. \quad (2)$$

Как видно, подключение дополнительных детекторов нивелируется большой динамической емкостью. В результате не возникает затяжек с перетеканием зарядов между емкостями C_1 и C_2 . Кинетика сигнала системы практически полностью определяется детектором, в который в данный момент попала частица.

Далее, импульс на выходе предусилителя будет иметь амплитуду $\cong (q/C_f)$ и кинетику согласно формуле (1). Здесь C_f емкость обратной связи предусилителя. В принципе, различия фронта нарастания сигнала от детектора к детектору могут сказаться на амплитуде $A(t)$ после формирования RC -фильтрами усилителя.

Преобразование сигнала фильтром с цепью интегрирования–дифференцирования ($\tau_{\text{инт}}; \tau_{\text{диф}}$) для линейно нарастающего сигнала с фронтом T рассмотрено в монографии [4]. Для используемых на практике равных постоянных $\tau_{\text{инт}} = \tau_{\text{диф}} = \theta$ зависимость дефицита амплитуды $(A_0 - A)/A_0 = f(\theta)$ представлена на рис. 1, кривая 1. Можно показать, что практически до $T/\theta < 3$ функция аппроксимируется квадратичной зависимостью

$$\cong \frac{1}{24} \left(\frac{T}{\theta} \right)^2.$$

В нашем случае возникает необходимость провести расчет для экспоненциально нарастающего сигнала на входе

фильтра $q(t) = 1 - \exp(-t/\tau)$. Используя операторный метод, для амплитуды на выходе фильтра получаем:

$$A(t) = \frac{\theta}{\theta - \tau} \exp\left(-\frac{t}{\theta}\right) \left[\frac{t}{\tau} - \frac{\tau}{\theta - \tau} + \frac{\tau}{\theta - \tau} \exp\frac{t}{\theta} \left(1 - \frac{\theta}{\tau}\right) \right]. \quad (3)$$

В эксперименте регистрируется максимальное значение импульса, определяемое уравнением $dA/dt = 0$. Последнее позволяет найти t_{\max} и соответствующую ему амплитуду A_{\max} при различных параметрах τ/θ . Проведя указанную процедуру, получаем для

$$\frac{A_0 - A_{\max}}{A_0} = f(\tau/\theta)$$

кривую 2 на рис. 1. Видно, что для равных T/θ и τ/θ в широком диапазоне значений аргумента значения дефицита при экспоненциальном фронте больше примерно на порядок.

Для сопоставления расчета с практикой возьмем характерную для задач прецизионной α -спектрометрии величину $\tau \cong 10^{-8}$ с. Тогда в системе детекторов при вариации τ в пределах $(1-2)10^{-8}$ с и постоянной формирования $\theta = 0.5$ мкс (большие загрузки) получаем разброс значений дефицита $\cong 3.3$ кэВ для линии 5.5 МэВ, то есть вполне заметную величину.

Более существенно проявление RC -формирования в случае замедленной реакции базы детектора (см. рис. 1, a). Последняя возникает при компенсации проводимости глубокими уровнями. Так, работа детекторов в условиях сильного фона нейтронов вызывает изменение проводимости вплоть до $n \rightarrow p$ конверсии. Возрастает концентрация ионизирующихся в поле ОПЗ примесей [5] и обеднить структуру детектора полностью не удается. При глубокой компенсации кремний имеет $\rho \cong 2.5 \cdot 10^5$ Ом·см, то есть $R_b C_b \cong 2.5 \cdot 10^{-7}$ с. Это ограничивает быстродействие схемы. Например, для $\theta = 10^{-7}$ с дефицит амплитуды составит $0.5(1 - (w/d))$.

2. Выше облучаемый детектор полагался генератором тока, δ -импульс которого имел заряд q . Рассмотрим теперь, насколько отличаются детекторы в отношении переноса заряда в ОПЗ. Очевидно, что на процесс переноса не может влиять подключение других детекторов.¹ Однако в детекторах может различно протекать рекомбинация неравновесного заряда, а также отличаться величина "входного окна".

¹ Действительно, в режиме обратного смещения $p^+ - n - p^+$ структуры блокируется поступление каких-либо носителей тока из внешней цепи.

В работе поставлен эксперимент по спектрометрии α -частиц Th^{228} . Фиксировалась амплитуда сигналов для линий $E_\alpha = 8.78$ и 6.28 МэВ как функция напряжения смещения U . При этом детектор марки ДКПс площадью 1 см^2 включался в цепь одиночно либо параллельно ему подключался детектор той же партии.

Зависимость амплитуды сигнала $A(U)$ можно описать формулой

$$A(U) \sim \frac{q}{C_f} \left(1 - \frac{C_{\text{вх}} + C(U)}{C_{\text{дин}}} \right) \left[1 - \frac{\Delta E_d}{E_\alpha} - \frac{k}{\sqrt{U}} \frac{1}{\tau_{\text{эфф}}} \right]. \quad (4)$$

Здесь $C_{\text{дин}}$ — динамическая емкость предусилителя, ΔE_d — потери энергии в мертвом слое детектора, $\tau_{\text{эфф}}$ — эффективное время жизни носителей в состоянии плазмы трека (учитывается объемная и поверхностная рекомбинация), k — коэффициент, определяющий время плазмы.

Поскольку $C \sim U^{-1/2}$, оба сомножителя имеют одинаковую функциональную зависимость ($a - b/\sqrt{U}$). Однако механизмы этой зависимости сугубо различны. Рост амплитуды с уменьшением емкости детектора является радиотехническим эффектом. Он ослабляется в зарядочувствительном предусилителе за счет большого значения $C_{\text{дин}} \sim 10^4$ пФ. Однако вклад его сопоставим с физическим аспектом, — ростом $A(U)$, — вследствие более полного собирания заряда с возрастанием электрического поля (см. напр. [6]).

Разделить вклады указанных механизмов удобно с помощью эталонных импульсов заряда, поступающих на вход предусилителя от генератора стабильной амплитуды. Очевидно, что $A_g(U)$ будет определяться ходом коэффициента преобразования электроники (первым сомножителем). Отношение амплитуд сигналов детектора и генератора $A/A_g(U)$ будет передавать изменения в процессе переноса заряда непосредственно в ОПЗ детектора.

На рис. 2 приведены результаты построения A_g и отношения A_α/A_g в зависимости от $U^{-1/2}$. Видно, что ход $A_g(U^{-1/2})$ (правая ордината рис. 2) с высокой точностью описывается прямой линией. Это оправдывает использование A_g в качестве нормирующего множителя. Далее, измерив емкость детектора от U и воспользовавшись формулой (4), было получено значение $C_{\text{дин}} \cong 2 \cdot 10^4$ пФ, что соответствует паспорту предусилителя.

Прямые 2 и 3 передают характер снижения рекомбинационных потерь заряда с ростом U при спектрометрии α -линий 8.78 и 6.28 МэВ соответственно. Четко прослеживается, что подключение второго “пассивного” детектора

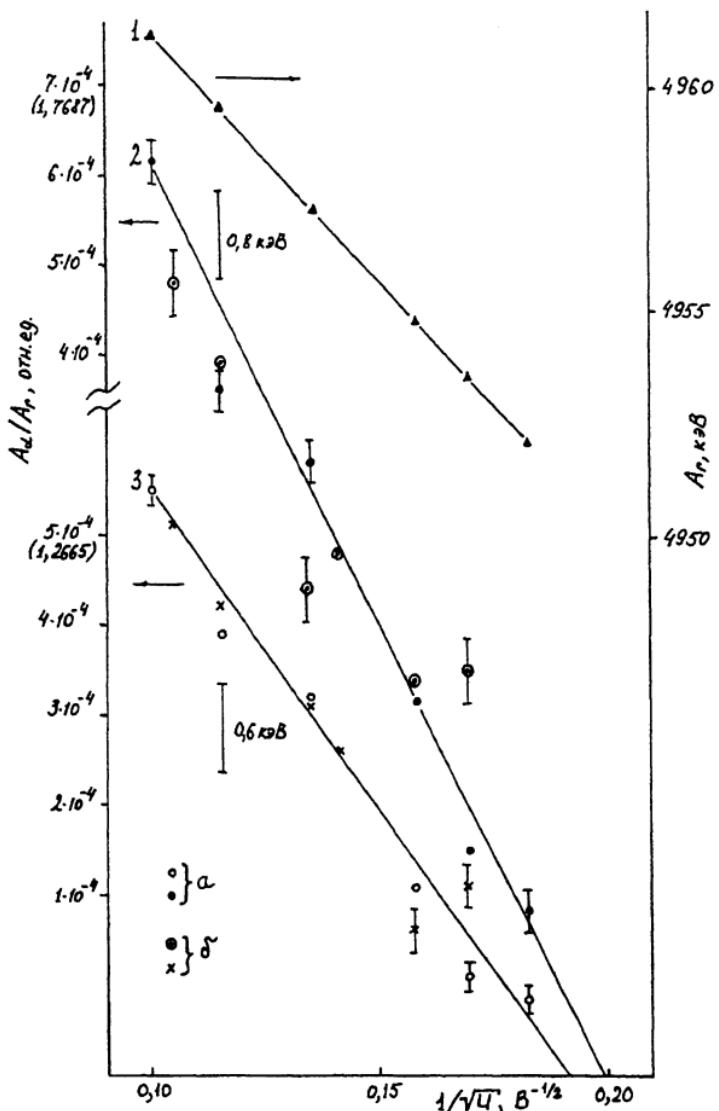


Рис. 2. Амплитуда сигнала поверхностино-барьерного детектора как функция напряжения смещения.

1 — положение пика генератора A_r (правая ордината), 2, 3 — относительные значения сигналов A_α/A_r при облучении α -частицами $E_\alpha = 8.78$ и 6.28 МэВ. а — детектор № 27, б — параллельно к № 27 подключен детектор № 22.

(группа точек б) не оказывается на ходе $A_\alpha/A_r(U)$ с точностью не хуже $10^{-2}\%$.

Как следствие, амплитудный спектр при одновременном облучении обоих детекторов является простой суммой индивидуальных спектров. Было обнаружено, что значения A_{\max} для детекторов разняются на 3 кэВ. Эта величина проявляется при суммировании, усугубляя размытие линий. Однако, в нашем случае было реализовано (за вычетом шума) разрешение 25 кэВ (0.28%) на линии 8.78 МэВ при пло-

щади 2 см^2 . Различие в A_{\max} может быть объяснено двумя причинами (см. (4)). Большая часть обусловлена индивидуальными различиями рекомбинации в детекторах, а меньшая — разницей в ширине мертвого слоя. Последняя была получена экстраполяцией $A_\alpha(U)$ на бесконечное поле и для нашего случая составила 50 \AA (в кремниевом эквиваленте).

В итоге можно сделать следующие выводы:

1. Система параллельно включенных детекторов с высокой степенью точности работает как один детектор, в который в данный момент попала частица. Вклад радиотехнических характеристик "пассивных" детекторов проявляется в возникновении дополнительной экспоненциальной компоненты, амплитуда которой в эксперименте не превосходит нескольких процентов.

2. Основным источником уширения спектральной линии системы являются различия в собранном заряде входящих в нее детекторов. В нашем эксперименте, при использовании детекторов из одной партии разность амплитуд заряда составило 3 кэВ.

3. Экспоненциальное нарастание сигнала по сравнению с линейным на порядок увеличивает "радиотехнический" дефицит амплитуды при формировании RC -фильтрами.

Список литературы

- [1] Grinberg J.S. // IRS Trans. 1962. NS-9. N 3. P. 149.
- [2] Вербицкая Е.М., Еремин В.К., Малыренко А.М., Строкан Н.Б., Суханов В.Л. // Письма в ЖТФ. 1986. Т. 12. В. 20. С. 1254–1258.
- [3] Еремин В.К., Даненгирш С.Г., Строкан Н.Б., Тиснек Н.И. // ФТП. 1974. Т. 8. В. 3. С. 556–561.
- [4] Gillespie A.B. // Signal, noise and resolution in nuclear counter amplifiers. London Pergamon Press, 1953. P. 155.
- [5] Wunstorf R., Bencert M., Claussen N., Croitorn N., Fretwurst E., Lindstrom G., Schulz T. // Nucl. Instr. Meth., Phys. Res. 1992. V. A315. P. 149–155.
- [6] Verbitshaya E., Eremin V., Strokan N., Kemeer J., Schmidt B., von Borani I. // Nucl. Instr. Meth. 1993. В печати.

Физико-технический институт
им. А.Ф.Иоффе
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию
24 декабря 1993 г.